

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年5月17日 (2012.5.17)

【公開番号】特開2010-287634(P2010-287634A)

【公開日】平成22年12月24日 (2010.12.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-051

【出願番号】特願2009-138696(P2009-138696)

【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/417 (2006.01)

H 0 1 L 29/423 (2006.01)

H 0 1 L 29/49 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 29/78 6 1 6 S

H 0 1 L 29/78 6 1 8 E

H 0 1 L 29/78 6 1 6 K

H 0 1 L 29/50 M

H 0 1 L 29/58 G

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月28日 (2012.3.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 3 】

上記目的を達成するため、本発明の第 2 の観点に係るトランジスタを有するトランジスタ基板の製造方法は、

チャンネル領域として機能する第 1 の半導体層と、

前記第 1 の半導体層の上に形成された第 2 の半導体層と、

前記第 1 の半導体層と前記第 2 の半導体層のチャンネル長方向の側面を覆うように設けられたオーミックコンタクト層と、を備えたトランジスタを有するトランジスタ基板の前記オーミックコンタクト層を、前記第 1 の半導体層及び前記第 2 の半導体層のチャンネル長方向の側面のみでコンタクトするよう形成することを特徴とする。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 5】

チャンネル領域として機能する第 1 の半導体層と、

前記第 1 の半導体層の上に形成された第 2 の半導体層と、

前記第 1 の半導体層と前記第 2 の半導体層のチャンネル長方向の側面を覆うように設けられたオーミックコンタクト層と、を備えたトランジスタを有するトランジスタ基板の前記オーミックコンタクト層を、前記第 1 の半導体層及び前記第 2 の半導体層のチャンネル

長方向の側面のみでコンタクトするよう形成することを特徴とするトランジスタを有するトランジスタ基板の製造方法。